PCT

国際事務局



特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6

C08G 73/10, 77/455

(11) 国際公開番号

WO95/33000

A1

(43) 国際公開日

1995年12月7日(07.12.95)

(21) 国際出願番号

PCT/JP95/01039

(22) 国際出頭日

Ĵ

1

1995年5月30日(30.05.95)

(30) 優先権データ

特願平6/140840

1994年5月31日(31.05.94)

TP

(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について)

新日銀化学株式会社

(NIPPON STEEL CHEMICAL CO., LTD.)[IP/IP]

〒104 東京都中央区銀座五丁目13番16号 Tekyo, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出顧人(米国についてのみ)

古川信之(FURUKAWA, Nobuyuki)[JP/JP]

〒803 福岡県北九州市小倉北区中井4-7-4-401 Fukuoka, (JP)

藤山 毅(FUJIYAMA, Takeshi)[JP/JP]

〒803 福岡県北九州市小倉北区原町1-3-30 Fukuoka, (JP)

谒浅正敏(YUASA, Masatoshi)[JP/JP]

〒803 福岡県北九州市小倉北区中井4-7-1-203 Fukuoka, (JP)

(74) 代理人

弁理士 藤本博光, 外(FUJIMOTO, Historius et al.) 〒100 東京都千代田区永田町二丁目14番2号

山王グランドビルヂング3階317区 藤本特許法律事務所

Tokyo, (JP)

(81) 指定国

US, 欧州特許(AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT,

LU, MC, NL, PT, SE).

添付公開杏類

国際調查報告書



(54) Tide: POLYIMIDE CONTAINING SILICATE GROUPS

(54) 発明の名称 シリケート基含有ポリイミド

(57) Abstract

The invention provides a novel polyimide containing silicate groups, which is excellent in mechanical and electrical properties, heat resistance and also the formability into film, and a film-forming heat-resistant material excellent in solvent and bending resistances and bondability. The polyimide has representing units each represented by general formula (1) and is produced from a tetracarboxylic acid anhydride and a diamine having at least one alkyl silicate group as the side-chain substituent. In said formula (1) Arı represents a tetravalent organic group; R₁ and R₂ are absent or each represents C₁-C₄ alkylene or phenylene; R₃ to R₇, R₉ and R₁₀ represent each C₁-C₆ hydrocarbyl; R₈ represents ethylene or C₃-C₆ alkylene; m and n represent each independently an integer of 1 to 10; and k represents an integer of 0 to 2. an integer of 0 to 2.

BEST AVAILABLE COPY

(57) 要約

機械的特性、耐熱特性、電気的特性に優れ、しかもフィルム形成能に優れた新 規なシリケート基含有ポリイミド樹脂を提供すると供に、優れた耐溶剤性、耐屈 曲性、接着性を有するフィルム形成可能な耐熱材料を提供する。

下記一般式(1)

(式中、Ariは4価の有機基を示し、Ri、Riは存在しないか又は炭素数1~4のアルキレン基又はフェニレン基を示し、Ri~Ri~Ri。、Riは炭素数1~6の炭化水素基を示し、Riはエチレン基又は炭素数3~6のアルキレン基を示し、m、nはそれぞれ独立に1~10の整数を示し、kは0~2の整数を示す)

で表される繰り返し単位を有するシリケート基含有ポリイミドであり、テトラカルボン酸無水物と、側鎖置換基として少なくとも1個のアルキルシリケート基を 有するジアミン成分より製造される。

情報としての用途のみ。 PCTに基づいて公開される国際出版をパンフレット第一頁にPCT加盟国を同定するために使用されるコード

AM Tルステートインシン・ファンス・インシン・ファンス・インシン・ファンス・ファートインシン・ファン・ファートインシン・ファートインシン・ファート・ア・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー	LK スリット・アンドルア サイン・アンドン・アンドン・アンドン・アンドン・アンドン・アンドン・アンドン・アン
--	---

明 紐 書

シリケート基含有ポリイミド

技 術 分 野

本発明は、ポリイミド樹脂、特にポリマー側鎖にアルキルシリケートを有する ポリイミド樹脂に関するものである。

背景.技術

ポリイミド系樹脂は、耐熱性、電気特性、機械的特性に優れ、フィルム、コーティング剤、あるいは成形材料として幅広く利用されている。近年、ポリイミド樹脂の可撓性を利用し、接着材料としての応用も検討されている(特開平3-17472号公報)。しかし、これらは、いずれも直鎖型の熱可塑性ポリイミドであり、ガラス転移温度以上での強度が極度に低下し、耐溶剤性に劣るという欠点を有していた。これを改良するために、ジアミノシロキサン等のソフトセグメントを共重合させることが検討されている(特開平4-36321号公報、特開平5-112760号公報)。また、末端に架橋性基を有する熱硬化型ポリイミドも開発されている(特開平3-259980号公報)。しかし、これらは、低分子量のオリゴマーであるためフィルム形成が困難で、ワニスとしての使用に限定され、また、高い硬化温度を必要とするという欠点を有していた。

発明の開示

本発明は、上記従来技術の欠点を克服し機械的特性、耐熱特性、電気的特性に 優れ、しかもフィルム形成能に優れた新規なシリケート基含有ポリイミド樹脂を 提供すると供に、優れた耐溶剤性、耐屈曲性、接着性を有するフィルム形成可能 な耐熱材料を提供するものである。

すなわち、本発明は、下記一般式(1)

$$\begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 \\
C & C & R_{5} & R_{5} & R_{6} \\
0 & A_{1} & N-R_{1}(S_{1}O)_{m}-(S_{1}O)_{m}-S_{1}R_{2} \\
0 & 0 & R_{4} & R_{6} & R_{7} \\
0 & 0 & (R_{9})_{4} S_{1}(OR_{10})_{3-4}
\end{bmatrix}$$
(1)

(式中、 Ar_1 は 4 価の有機基を示し、 R_1 、 R_2 は存在しないか又は炭素数 $1\sim4$ のアルキレン基又はフェニレン基を示し、 $R_3\sim R_7$ 、 R_9 、 R_{10} は炭素数 $1\sim6$ の炭化水素基を示し、 R_4 はエチレン基又は炭素数 $3\sim6$ のアルキレン基を示し、m、n はそれぞれ独立に $1\sim1$ の整数を示し、k は $0\sim2$ の整数を示す)

で表される繰り返し単位を有するシリケート基含有ポリイミドであり、また、一般式(1)で表される繰り返し単位1~80モル%、下記一般式(2)

(式中、Ar2 は4価の有機基を示し、Ar3 は少なくとも3個の芳香環を有する2価の有機基を示す)

で表される繰り返し単位20~99モル%よりなるシリケート基含有ポリイミドである。

前記一般式 (1) で表される繰り返し単位はテトラカルボン酸無水物とジアミンより構成されるが、式中の Ar_1 は原料であるテトラカルボン酸無水物を構成する 4 価の有機基であって、そのようなテトラカルボン酸無水物としては、具体的には、3, 3', 4, 4' ージフェニルテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4' ージフェニルデトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4' ージフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物、3, 3', 4, 4' ージフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、2, 2 ービス(3, 3', 4, 4' ーテ

トラカルボキシフェニル)へキサフルオロプロパン二無水物、2.3.3',4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物、2.3,3',4'ービンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、2.3,3',4'ージフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物、2.3,3',4'ージフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物、2.2ービス(3.4ージカルボキシフェノキシフェニル)プロパン二無水物、2.2'ービス(3.4ージカルボキシフェノキシフェニル)スルホン二無水物等の少なくとも2個の芳香環を有するテトラカルボン酸二無水物が挙げられるが、ピロメリット酸無水物、1.4.5.8ーナフタレンテトラカルボン酸無水物、2.3.6.7ーナフタレンテトラカルボン酸無水物等のテトラカルボン酸無水物を用いることもできる。

さらに本発明に用いる前記一般式(1)を構成するためのジアミン成分として 具体的には、

(式中、Phはフェニレン基を表し、m、nはそれぞれ独立に、 1~10の整数を示す。)

CH2Si(OC2H5)3

等が挙げられるが、側鎖置換基として少なくとも1個のアルキルシリケート基を 有していれば、これらに限定されず用いることができる。さらにこれらは、1種 またはそれ以上を組み合わせて用いることができる。

また、前記一般式(1)で表される繰り返し単位を構成する方法としては、下記一般式(4)

(式中、 R_{11} 、 R_{12} は存在しないか又は炭素数 $1\sim4$ のアルキレン基又はフェニレン基を示し、 $R_{13}\sim R_{17}$ は炭素数 $1\sim6$ の炭化水素基を示し、

p、qはそれぞれ独立に1~10の整数を示す)

で表されるビニル基含有ジアミノシロキサンとテトラカルボン酸二無水物から、 下記一般式(5)

$$\begin{bmatrix}
0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 \\
C & C & R_{13} & R_{15} & R_{16} \\
N - R_{11} & (Si0)_{p} - (Si0)_{q} - SiR_{12} \\
0 & 0 & R_{14} & CH = CH_{2}R_{17}
\end{bmatrix}$$
(5)

(式中、 Ar_1 は 4 価の有機基を示し、 R_{11} 、 R_{12} は存在しないか又は炭素数 $1\sim4$ のアルキレン基又はフェニレン基を示し、 $R_{13}\sim R_{17}$ は炭素数 $1\sim6$ の炭化水素基を示し、p、q はそれぞれ独立に、 $1\sim1$ 0 の整数を示す)

で表される繰り返し単位を構成させた後、下記一般式(6)

$$(R_{21}O)_{3-x} SiH(R_{22})_x$$
 (6)

(式中、R21、R22は炭素数1~6の炭化水素基を示し、

x は 0 ~ 2 の整数を示す)

で表される化合物とのヒドロシリル化反応により製造することもできる。

前記一般式(4)で表されるビニル基含有ジアミノシロキサンの具体例として は、

(a)
$$H_2N (CH_2)_3 - (SiO)_b (SiO)_c - Si (CH_2)_3 NH_2$$

 $CH_3 CH = CH_2 CH_3$

(b)
$$H_2N (CH_2)_4 - (SiO)_p (SiO)_q - Si (CH_2)_4 NH_2$$

 $CH_3 CH = CH_2 CH_3$

(d)
$$H_2N$$
 (CH_2), — (SiO), (SiO), — Si (CH_2), NH_2

| Ph | CH = CH₂ Ph

(e)
$$H_2N (CH_2)_4 - (SiO)_6 (SiO)_6 - Si (CH_2)_4 NH_2$$

 $Ph CH = CH_2 Ph$

(式中、Phはフェニル基を示し、p、qはそれぞれ独立に、

.1~10の整数を示す)

等が挙げられるが、側鎖置換基として少なくとも1個のビニル基を有していれば 、これらに限定されず用いることができる。

また、前記一般式(6)で表されるヒドロアルキルシリケート化合物の具体例 としては、

- (a) HSi (OCH3)3
- (b) HSi (OC₂H₅)₃
- (c) HSi (CH₃) (OCH₃)₂
- (d) HSi (CH₃) (OC₂H₅)₂
- (e) HSi(CH₃)₂(OCH₃)
- f HSi (CH₃)₂ (OC₂H₅)
- (g) HSi (C₂H₅) (OCH₅)₂
- (h) HSi (C₂H₅)₂ (OCH₃)
- (i) $HSi(C_2H_5)(OC_2H_5)_2$ (i) $HSi(C_2H_5)_2(OC_2H_5)$
- (k) HSi (OCH2 CH2 OCH3)3
- (1) HSi (OCH2 CH2 OC2H5)3

等が挙げられるが、ヒドロアルキルシリケート基を含有する化合物であれば、これらに限定されず使用することができる。

さらに、これらヒドロアルキルシリケートと前記一般式(5)で表されるビニル基含有ポリマーと反応させて、前記一般式(1)で示される繰り返し単位を構成させる際、反応触媒として、塩化白金酸等を用いることができる。

また、前記一般式(5)で示される繰り返し単位のビニル基と反応させる際、 これらヒドロアルキルシリケート化合物は、ビニル基当量に対し、1.0~5. 0モル当量の範囲で用いることが好ましい。

前記一般式(2)で示される繰り返し単位を構成するために用いるジアミン成分としては、4、4'ージアミノジフェニルエーテル、4、4'ージアミノジフェニルスルフィド、2、2ービス(4ーアミノフェノキシフェニル)プロパン、ビス [4ー(4ーアミノフェノキシ)フェニル]スルホン、ビス [4ー(3ーアミノフェノキシ)フェニル]スルホン、4、4'ービス(4ーアミノフェノキシ)ジフェニル、1、4ービス(4ーアミノフェノキシ)ベンゼン、2、2ービス(4ーアミノフェノキシフェニル)へキサフルオロプロパン、1、4ージアミノベンゼン、2、5ージアミノトルエン等が挙げられるが、少なくとも3個の芳香環を有するジアミノ化合物を用いることが好ましい。

さらに、

- (a) 4- (3-ヒドロキシフェノキシカルボニル) -1, 3-ジアミノベンゼ ン

ン

- (c) 4-(4-ヒドロキシフェノキシカルボニル) -1, 3-ジアミノベンゼン
- (e) 5-(3-ヒドロキシフェノキシカルボニル) -1, 3-ジアミノベンゼン
- $(g) 4 (2 7 \le 1 7 \le 1 + 5) 1, 3 9 = 1 \le 1 \le 1 \le 1$
- (h) $4 (3 7 \le 1 7 \le 1 + 2) 1$, $3 3 3 2 \le 1 \le 1 \le 1 \le 1$
- (i) $4 (4 7 \le 1 7 \le 1 + 2) 1$, $3 9 \le 1 \le 1 \le 1 \le 1$
- $(j) 5 (2 7 \le 1 1 \le 1 + 2) 1, 3 3 3 3 \le 1 \le 1 \le 1$
- (k) 5 $(3-r \le 1/r \le$
- (m) $4 (3.5 7 \le 1) = 1.3 97 \le 1 < 100$
- (n) 4-(2-アミノフェノキシカルボニル)-1.3-ジアミノベンゼン 等のヒドロキシ甚、カルボキシル甚を有するジアミノ化合物またはトリアミン類 、テトラアミン類を用いることもできる。

このようにして合成した前記一般式(1)で示されるポリイミドは、シリケート基を側鎖に含有するため接着性能に優れ、しかも、加水分解反応、加熱加水分解反応により架橋構造を構成させることができため、耐熱性、強度、耐溶剤性にすぐれた材料となる。

図面の簡単な説明

図1は、実施例1で得られたシリケート基含有ポリイミドの赤外吸収スペクト ル図である。

図2は、実施例1で得られたシリケート基含有ポリイミドの熱機械的分析 (T MA) 特性図である。

発明を実施するための最良の形態

以下に、実施例に基づいて、本発明を更に詳しく説明する。なお、本実施例で 用いた略号は、以下の化合物を示し、表中の括弧付記号は本明細書中に記載した 化合物を示す。

化合物の略号

BTDA: 3, 3', 4, 4'ーペンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物

ODPA: 3, 3', 4, 4'ージフェニルエーテルテトラカルボン酸二無水物

DSDA: 3, 3', 4, 4'ージフェニルスルホンテトラカルボン酸二無水物

PMDA: ピロメリット酸無水物

 $BAPP: 2. 2- \forall x (4-(4-r) < 1/r)) 7 = - \lambda$

BAPS: ビス (4-(4-アミノフェノキシ) フェニル) スルホン

BAPS-N: ビス (4-(3-アミノフェノキシ) フェニル) スルホン

BAPB: 4, 4' ービス (4-アミノフェノキシ) ジフェニル

NMP: N-メチル-2-ピロリドン

DMAc: N, Nージメチルアセトアミド

PSX6:平均分子量800のジアミノポリジメチルシロキサン化合物

PSX7: 平均分子量1200のジアミノポリジメチルシロキサン化合物

合成例1

乾燥NMP150m1中に、BAPP37.0g(0.09mo1)、架橋性官能基を有するジアミノ化合物(a)8.5g(0.01mol)を加え溶解した。続いて、溶液温度を30℃以下に保ちODPA31.1g(0.10mol)を少量づつ加え、約5時間授拌し重合反応を行い、ポリアミド酸溶液を得た。Dean-Shyutark型の反応器で、合成したポリアド酸溶液中に、m-+シレン50gを添加し、180℃に加熱し、溶液イミド化を行った。反応終了後、室温まで冷却した後、ヒドロトリエトキシシラン(0.12mol)を少量ずつ添加した。全量添加した後、ヒドロシリル化触媒として、塩化白金酸(H_2 PtCl6・ H_2 O)0.01gを加え、5時間反応させた。反応終了後、室温まで冷却し、樹脂溶液の一部をガラス基板上にキャストし、100℃(1時間)で乾燥し、ガ

ラス基板上から剥離し、金属枠にフィルムを固定した後、150 \mathbb{C} (30 \mathbb{C}) 、200 \mathbb{C} (10 \mathbb{C}) 、にてポリイミドフィルムを作成した。

実施例1

BTDA32.2g、BAPP37.0g、ジアミノシロキサン(A)8.5 gを原料として用い、合成例1の方法で、シリケート基含有ポリイミドを合成した。その赤外吸収スペクトルを図1に、また、TMA特性を図2に示した。さらに200 $^{\circ}$ で(1時間)の熱処理を行い、硬化後の樹脂特性を測定した。その結果を表1に示した。

実施例2~12

合成例1の方法を用い、重合反応を行なった。その重合モノマー組成および重合結果を表1に示した。

さらに、ポリイミドフィルムを作成したのち、基本物性を測定した。その結果 を表1に併せて示す。

比較例1~4

アルキルシリケート基を有しないジアミノシロキサンを用いる以外は、合成例 1と同様に樹脂を合成した。

その組成及び基本物性を表1に示した。これらの樹脂は、150 \mathbb{C} (30 \mathcal{G})、200 \mathbb{C} (10 \mathcal{G}) でフィルム作成し、物性を測定した。また、さらに、このフィルムを200 \mathbb{C} (1 時間) 処理した後、再度物性測定を行ったが、その物性の変化はほとんど無かった。

表1

		実施例							
		1	2	3	4	5	6	7	8
樹脂原料	カルキン酸 無水物 (モル%)	BTDA 100	DSDA 100	BTDA 100	ODPA 100	BTDA 90 PMDA 10	DSDA 50 BTDA 50	BTDA 100	DSDA 100
	ジブミン化合 物(モルX) と Fロブルコキシ シラン 化合 物(モルX) ¹³	BAPP 90 (A) 10	BAPS-N 90 (B) 10	BAPP 80 (C) 20	BAPB 80 (D) 20	BAPS 70 (E) 30	BAPS-N 70 (a) 30 (a)	BAPS-N 80 (b) 20 (b)	BAPS-N 90 (a) 10 © 2
*	溶媒 b度(cps)	NMP 5.000	NMP 7.000	NMP 4.000	NXP 5,500	NMP 3, 500	NMP 4.500	NMP 4.000	DMAc 5.000
↔ 硬化前の特性	2) 弾性率 kg/mm² 2) 強度 kg/mm² 2) 伸び% 3) ガラス転 移温度℃	240 18. 4 20. 2 210	255 17. 5 15. 1 203	220 17. 2 10. 6 192	215 158 22. 3 205	200 14. 1 34. 0 182	195 12. 8 31. 5 167	215 17. 2 18. 0	225 19. 0 15. 4 198
5 耐薬品性	クロロネルム ジクロロメタン トリクレン アセトン メタノ・ル DMF NMP	0000000	0000000	0000000	0000000	0000044	0000044	0000004	0000000
5 硬化後の物性	2) 弾性率	252	267	235	225	220	206	223	234
	kg/m² ²> 強度	20. 3	19. 2	19. 0	18. 1	16.3	14. 0	19. 0	21. 1
	kg/mm² ²⁾ 伸び% ³⁾ #57年	19. 0	14.3	9. 6	20. 5	27. 2	27. 2	15. 3	10. 2
	3) 护汉転 移温度℃	217	212	208	220	195	180	195	211

表1 (続き)

		実施例			比較例				
		9	10	11	12	1	2	. 3	4
樹脂原料	カルギン酸 無水物 (モル%)	BTDA 100	DSDA 100	BTDA 100	ODPA 100	BTDA 90 PMDA 10	DSDA 50 BTDA 50	BTDA 100	DSDA 100
	ジブミン化合 物(モル%) tドロアルコキシ シラン 化合 物(モル%) ¹⁾	BAPS 90 (A) 10 D	BAPS-M 90 (B) 10	BAPP 80 (C) 20	BAPB 80 (D) 20 a) 2	BAPS 70 PSX6 30	BAPS-M 70 PSX6 30	BAPS-N 80 PSX7 20	BAPS-N 90 PSX7 10 (a) 2
	表 (NMP 5. 000	NMP 7, 000	NMP 4.000	NMP 5, 500	NMP 3, 500	NMP 4.500	DMAc 4.000	NMP 5, 000
→ 硬化前の特性	21 弾性率 kg/mu ² 21 強度 kg/mu ² 21 伸び% 31 ガラス転 移温度℃	235 18. 4 20. 2 225	225 17. 5 15. 1 195	200 17. 2 10. 6 202	220 15. 8 22. 3 237	200 14. 1 34. 0 225	165 12. 8 31. 5 240	183 18. 2 18. 0 265	255 19. 0 15. 4 235
5) 耐薬品性	クロロネルム ジクロロメタン トリクレン アセトン メタノール DMF NMP	0000000	0000000	0000000	0000000	∆∆∆00∆×	× × × O ×	× × △00 × ×	× 4 4 0 0 × ×
6) 硬化後	2) 弾性率	242	270	213	237	—			
	kg/mm² ²' 強度 kg/mm²	19. 1	18. 2	18. 3	16. 2	—			
仮の物	kg/mm ² 伸び% 3) ガラス転	18. 0	14. 0	10. 2	20.5				
性性	移温度℃	236	208	221	244		_		

¹⁾ビニル基に対するモルパーセント 2)引張試験(ASTN D-882-64-T) 3)熱機械的分析(TNA) 4)フィルム形成後の測定値

5)フィルム浸漬 1hr後の評価 ○: 不溶. △: 膨潤. ×: 溶解 6) 200℃/1hr処理後の測定値

産業上の利用可能性

本発明のポリイミド樹脂は、フィルム状、粉体状あるいはワニス状で用いることができる。また、本発明によるポリイミド樹脂は、ポリイミド側鎖に、アルキルシリケート基を有するため、架橋反応により耐熱性、耐薬品性を向上させることができる。これらの具体的用途としては、耐熱性接着材料、エポキシ樹脂改質剤、耐熱性塗料、複合材料用樹脂、電子材料用コーティング剤、プリント基板用接着フィルム、成型材料等の幅広い用途が期待できる。

譲 求 の 範 囲

1. 下記一般式(1)

(式中、 Ar_1 は 4 価の有機基を示し、 R_1 、 R_2 は存在しないか又は炭素数 $1\sim 4$ のアルキレン基又はフェニレン基を示し、 $R_3\sim R_7$ 、 R_9 、 R_{10} は炭素数 $1\sim 6$ の炭化水素基を示し、 R_8 はエチレン基又は炭素数 $3\sim 6$ のアルキレン基を示し、m、n はそれぞれ独立に $1\sim 1$ の整数を示し、k は $0\sim 2$ の整数を示す)

で表される繰り返し単位を有するシリケート基含有ポリイミド。

2. 一般式(1)で表される繰り返し単位1~80モル%、下記一般式(2)

(式中、Ar2は4価の有機基を示し、Ar3は少なくとも3個の芳香環を有する2価の有機基を示す)

で表される繰り返し単位20~99モル%よりなることを特徴とする請求項1記 載のシリケート基合有ポリイミド。

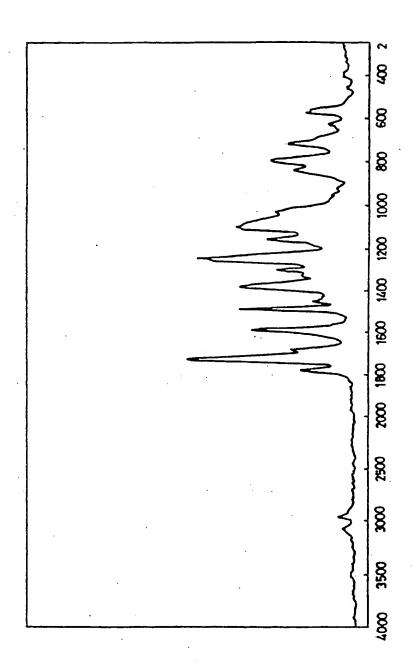
3. 一般式(1)で示される繰り返し単位のAr」が、下記一般式(3)



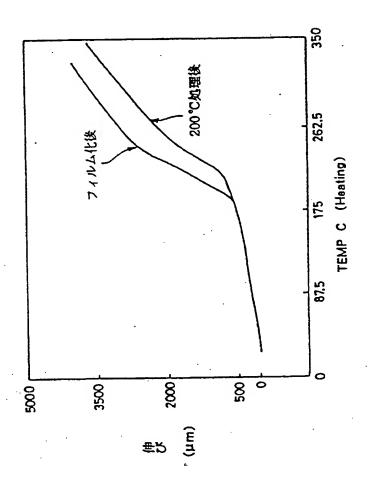
(式中、Zは存在しないか又は-O-、-SO₂-、-C(CF₃)₂-、 -CO-のいずれかを示す)

で表されることを特徴とする請求項1記載のシリケート基含有ポリイミド樹脂。

[図 1]



[🛛 2]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP95/01039

	SSIFICATION OF SUBJECT MATTER						
Int.	. Cl ⁶ C08G73/10, C08G77/455	5					
According t	to International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and IPC					
B. FIEL	DS SEARCHED						
Minimum d	ocumentation scarched (classification system followed by	classification symbols)					
Int	Int. Cl ⁶ C08G73/10, C08G77/455						
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the e	extent that such documents are included in the	ne fields scarched				
Electronic d	ata base consulted during the international search (name	of data base and, where practicable, search t	erms used)				
CAS	WPI/L	•					
			. ,				
C DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category*	Citation of document, with indication, where a	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
A	JP, 1-204931, A (Sagami Ch Center),	emical Research	1 - 3				
	August 17, 1989 (17. 08. 8 Claim (Family: none)	9),					
	•						
	·						
	·						
	·						
Furthe	Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.						
"A" docume	 Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance Takes document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention						
"L" docume	"E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is seen when the document is taken alone.						
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination							
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family							
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report							
Augu	nst 14, 1995 (14. 08. 95)	September 5, 1995 (05. 09. 95)				
Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer							
Japanese Patent Office							
Facsimile N	lo.	Telephone No.					

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

株式PCT/1SA/210 (第2ページ) (1992年7月)